

2SA956

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ / PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
 高周波増幅, 中速度スイッチング用 / High Frequency Amplifier, Medium Speed Switching
 通信工業用 / Industrial Use

特 徴 / FEATURES

- ・超小形パッケージを採用しており、ハイブリッドIC用として最適。
 Very small size to assure good space factor in hybrid IC applications.
- ・高周波増幅はもとより、スイッチング、低周波増幅など広範囲な回路に使用できます。
 Suitable for switching and audio amplifier as well as high frequency amplifier.
- ・耐圧が高く、電源電圧の変動に対して余裕がある。
 Keeps stabilized operation against power voltage fluctuation.
 $V_{CEO} > -40V$, $V_{EBO} > -8V$
- ・直流電流増幅率が高く、直線性が優れている。
 High DC current gain and excellent linearity.
 $h_{FE}(I_C = -10mA) : 160TYP.$

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-8.0	V
コレクタ電流	I_C	-100	mA
全損失	P_T	150	mW
ジャンクション温度	T_j	125	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ C$

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -40V, I_E = 0$			-100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0V, I_C = 0$			-100	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -1.0V, I_C = -1.0mA$	50	155		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -1.0V, I_C = -10mA$	80	160	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -10mA, I_B = -1.0mA$		-0.06	-0.3	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -10mA, I_B = -1.0mA$		-0.75	-1.0	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -10V, I_E = 10mA$	150	280		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1.0MHz$		7.5	10	pF
ターンオン時間	t_{on}	測定回路図参照 / See test circuit		100		ns
蓄積時間	t_{stg}			200		ns
ターンオフ時間	t_{off}			270		ns

h_{FE2} 区分 / h_{FE2} Classification

H3 : 80~130 H4 : 110~170 H5 : 150~240 H6 : 200~320

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)

